

# MA2C723 (MA723)

## シリコンエピタキシャルプレーナ形

超高速スイッチング用  
小電流整流用

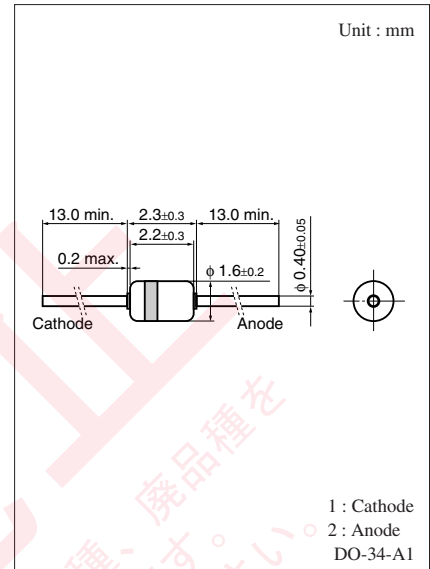
### ■ 特長

- 順電流(平均値)  $I_{F(AV)}$  = 200 mA の整流が可能
- 高密度実装(5 mm ピッチ挿入)が可能

### ■ 絶対最大定格 $T_a = 25^\circ\text{C}$

項目	記号	定格	単位
逆電圧	$V_R$	30	V
繰返し尖頭逆電圧	$V_{RRM}$	30	V
非繰返し尖頭順サージ電流*	$I_{FSM}$	1.5	A
順電流(尖頭値)	$I_{FM}$	300	mA
順電流(平均値)	$I_{F(AV)}$	200	mA
接合温度	$T_j$	150	$^\circ\text{C}$
保存温度	$T_{stg}$	-55 ~ +150	$^\circ\text{C}$

注) \*: 50 Hz 正弦波 1 サイクル波高値 (非繰返し)



カソード表示: Pink

### ■ 電気的特性 $T_a = 25^\circ\text{C} \pm 3^\circ\text{C}$

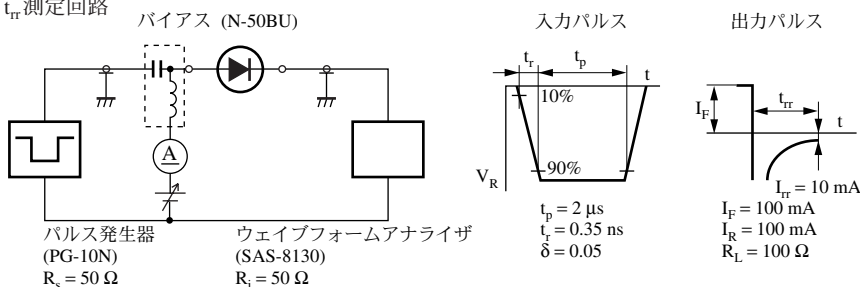
項目	記号	条件	最小	標準	最大	単位
順電圧	$V_F$	$I_F = 200 \text{ mA}$			0.55	V
逆電流	$I_R$	$V_R = 30 \text{ V}$			15	$\mu\text{A}$
端子間容量	$C_t$	$V_R = 0 \text{ V}, f = 1 \text{ MHz}$		20		pF
逆回復時間*	$t_{rr}$	$I_F = I_R = 100 \text{ mA}$ $I_{rr} = 10 \text{ mA}, R_L = 100 \Omega$		2.0		ns

注) 1. 測定方法は、日本工業規格 JIS C 7031 ダイオード測定方法によります。

2. 本製品は、静電気などの電気的ショックに弱いため、人体の帯電、使用機器の漏電には十分ご注意ください。

3. 定格入出力周波数: 1 GHz

4. \*:  $t_{rr}$ 測定回路



注) 形名の( )内は、従来品番です

